## 電場・磁場の単位について

- 電位φ 単位 V
- ・ 電場 $\vec{E} = -\vec{V}\phi$  単位 V/m  $-E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}$

C: クーロン、電荷の単位 F: ファラド、=C/V T: テスラ、 磁束密度の単位 Wb: ウェバー、磁束の単位 H: ヘンリー、=Wb/Aインダクタンスの単位

- 電東密度 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$  単位  $C/m^2$   $\varepsilon_0$ : 真空の誘電率  $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \, (F/m)$
- 磁場 H 単位 A/m
- 磁東密度 $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$  単位  $T = Wb/m^2$ 
  - $\mu_0$ : 真空の透磁率  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (H/m)$
  - 光速  $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$

# 物理学実験 I 電磁気学 交流電流と磁場

担当: 佐藤、浅野(TA) 連絡先:

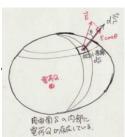
物理学専攻 素粒子実験研究室 内線4270 ksato@hep.px.tsukuba.ac.jp

#### 電磁気学の4つの基本法則

- ・ 電場についてのガウスの法則
  - $-\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\varepsilon_{0}, \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_{0}$
- ・ 磁束保存の式
  - $-\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0, \qquad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
- アンペールの法則 (j: 電流密度)
  - $-\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = I, \qquad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$
- ファラデーの電磁誘導の法則 (Φ<sub>B</sub>: 磁束)
  - $-\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_{\mathcal{S}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \Phi_{B}, \qquad \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{B}$

# 電場についてのガウスの法則

- $\iint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/\varepsilon_{0}$
- 右のような閉じた曲面内に電荷Q が存在している。
- 微小面積dŠを考える。
  - ds の向きは面積に垂直の方向。
- ・ この場所での電場が $\vec{E}$ なら、微小面積を突き抜ける電場の量(電東/ $\epsilon_0$ ) は、 $\vec{E}\cdot d\vec{S}$
- 公式の左辺は、閉曲面全体から出て行く電場を足し合わせたもの=電東/ $\epsilon_{\rm n}$ 。
- 閉曲面全体から出て行く電束は、 閉曲面内の電荷の量に一致する。



## ガウスの法則の例

- 原点に電荷Qが置かれているときに、 半径rの球面を考える。
- 球面上での電場は、動径方向に向いて いて、強さは

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

 球面の表面とEが垂直なので、EとdSは 並行、大きさだけ考えればよい。

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot dS$$

したがって、

$$\begin{split} \iint_S \ \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \times (球面の面積) \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \times 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0 \end{split}$$

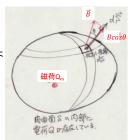


## 磁束保存の法則

- $\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
- 右のような閉じた曲面内に磁荷Q<sub>m</sub>が存在している。
- 電場のガウスの法則のときと同じように、以下が導かれる。

$$\iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = Q_{m}$$

- 現在までに、単独で存在する磁荷 は発見されていない。
  - 常に $Q_m = 0$
- 閉曲面全体から出て行く磁束は、 必ず0である。



## アンペールの法則

・ 電流 $\vec{I}$ が流れると、そのまわりに磁場 $\vec{H}$ が発生する。

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = I$$

例題:直線電流iの周り、半径rの地点での磁場の強さは?

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = I$$

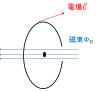
$$H = I/2\pi r$$



## 電磁誘導の法則

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \Phi_B$$

- t = t = 0,  $\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$
- この式は、磁束が時間変化したとき、 磁束の周りに電場が生じることを表している。

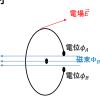


# 電磁誘導の法則

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \Phi_B$$

- t = t = 0,  $\Phi_B = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$
- この式は、磁束が時間変化したとき、 磁束の周りに電場が生じることを表している。
- 左辺は、電場×距離だから、電位差を 表しているとも考えられる。
- 右図のようなコイルを考えると、磁場の時間変化によって、コイルの両端に以下の電圧が発生する。

$$\Delta \phi = \phi_A - \phi_B = -\frac{\partial}{\partial t} \Phi_B$$



## ビオ・サバールの法則

• 磁束保存とアンペールの両法則から、電流が作る磁場の公式が導かれる:

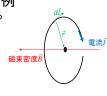
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \oint_C \frac{I \cdot d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

- ここで、Cは電流が流れる経路、 $d\vec{l}$ はCに沿った微小線素である。
- rは微小線素から磁場を観測する地点に向かうベクトル。

# ビオ・サバールの法則、ヘルムホル ツ・コイルの例

・ 半径aの円形電流が、その中心に作る 磁束密度は?

密度は?
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \oint_C \frac{I \cdot d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \oint_C \frac{I \cdot d\vec{l} \times a}{a^3}$$
$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot 2\pi a \times a}{a^3}$$
$$= \frac{\mu_0 I}{2a} = \overline{\tau} + \lambda + (1) \vec{\pi}$$



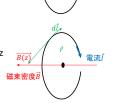
# ビオ・サバールの法則、ヘルムホル ツ・コイルの例

・ 半径aの円形電流が、その中心に作る磁束 密度は?



2a もう少し複雑な計算をすれば、中心軸上、z の点での磁束密度も計算できる。

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 a^2 I}{2(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

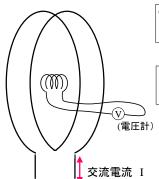


磁束密度

電流Ϊ

2

## 実験 1



① 大コイルに交流電流を 流し、交流磁場を発生させる。 (ビオ・サバールの法則)

#### B∝I

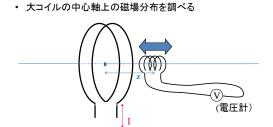
② 小コイルを大コイルの中 心に配置し、両端の交流電 圧を測る。(電磁誘導)

$$V \propto \frac{\partial B}{\partial t} \propto \frac{\partial I}{\partial t}$$

電流が正弦波なら、 $I = I_0 \cdot sin(2\pi ft)$  V  $\frac{\partial I}{\partial t} = 2\pi f I_0 \cdot cos(2\pi ft)$  Vは、 $fI_0$ に比例!!

#### 実験2 実験1の結果を応用

- ・ サーチコイルの電圧  $V \propto \frac{\partial B}{\partial t}$ 
  - ⇒ 磁場の相対的な大きさがわかる
  - ⇒ サーチコイルを磁場計として利用



# ヒューズ・抵抗箱



抵抗1Ω (両端の電圧 から電流値が わかる(オー ムの法則)

ヒューズ

# 大コイル (ヘルムホルツコイル)



#### サーチコイル



ヘルムホルツコイルの軸に対して平行に なるように注意

#### セットアップ写真



#### 実験Ⅰ

- ヘルムホルツコイル: f=1.6 kHzの設定で、電流I=100,50, 20, 10, 5 mA(RMS)でのサーチコイルの電圧 $V_S$ (RMS)を測 定する。(現セットアップでは200 mA以上、2mA以下は発信できない)
  - -I=0でノイズ $V_{BK}$ を測定しておく。
  - 両対数 x=I,  $y=V_S-V_{BK}$  のグラフ(図3a)
  - 両対数  $x=I, y=\frac{V_S-V_{BK}}{I}$ のグラフ(図3b)
- f=200 Hzで同じ測定をし、同じシートにプロットする。
- I=20mA(RMS)一定で、f=3.2k, 1.6k, 800, 400, 200, 100 HzでVsを測定する。
  - 両対数 x=f, y=V/Iのグラフ(図4)
  - 両対数 x=f, y=V/lfのグラフ

# レポート提出について

- ・ 提出期限: 12月7日午後5時まで。
- ・ 提出先: 1A棟3階(数理支援室)入口のメールボックス
- 連絡先:
  - ・物理学専攻 素粒子実験研究室 佐藤まで
  - 内線4270
  - ksato@hep.px.tsukuba.ac.jp

# 実験|| 注意事項

- I=100mA(RMS)、f=1.6kHzで実験する。
- 最低7点くらい取りたい: たとえばz=0, 1, 2, 4, 6,10, 20 cm - 両対数 x=z, y=Vのグラフ(図5)
  - 片対数 x(対数)=z, y(linear)=-<del>--</del>(= z<sub>0</sub>)グラフ(教科書 にはないが、このプロットを作成する) $\frac{\left(rac{V_0^{23}}{V}
    ight)^{3}-1}{\left(rac{V_0^{23}}{V}
    ight)^{3}}$

両辺を $\frac{2}{3}$ 乗して、  $\left(\frac{V}{V_0}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{a^2}{z^2 + a^2}$ 

両辺に
$$(z^2 + a^2) \left(\frac{v}{v_0}\right)^{\frac{2}{3}}$$
 をかければ、  $z^2 + a^2 = \left(\frac{v_0}{v}\right)^{\frac{2}{3}} a^2$ 

$$a^2$$
について解くと、 $a^2 = \frac{z^2}{\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}}-1}$  したがって、 $a = \frac{z}{\sqrt{\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\frac{2}{3}}-1}}$ 

4